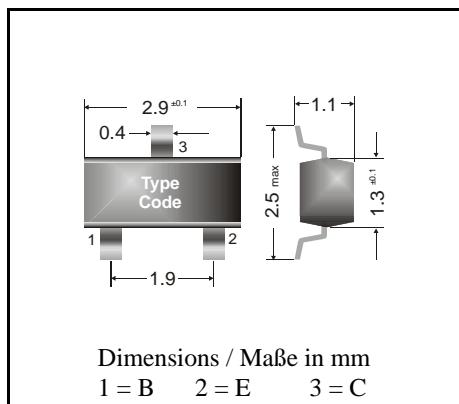


PNP

**Surface mount Si-Epitaxial Planar Transistors**  
**Si-Epitaxial Planar Transistoren für die Oberflächenmontage**

PNP

Version 2004-05-04



Power dissipation – Verlustleistung	250 mW
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

**Maximum ratings ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )****Grenzwerte ( $T_A = 25^\circ\text{C}$ )**

		<b>MMBT2907</b>	<b>MMBT2907A</b>
Collector-Emitter-voltage	B open	- $V_{CEO}$	40 V
Collector-Base-voltage	E open	- $V_{CBO}$	60 V
Emitter-Base-voltage	C open	- $V_{EBO}$	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		$P_{tot}$	250 mW <sup>1)</sup>
Collector current – Kollektorstrom (dc)		- $I_C$	600 mA
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- $I_{CM}$	800 mA
Junction temp. – Sperrschiichttemperatur		$T_j$	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	- 65...+ 150°C

**Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )****Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )**

		<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
Collector-Base cutoff current – Kollektorreststrom				
$I_E = 0, - V_{CB} = 50 \text{ V}$	MMBT2709	- $I_{CB0}$	–	20 nA
	MMBT2709A	- $I_{CB0}$	–	10 nA
$I_E = 0, - V_{CB} = 50 \text{ V}, T_j = 150^\circ\text{C}$	- $I_{CB0}$	–	–	20 $\mu\text{A}$
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>				
$- I_C = 150 \text{ mA}, - I_B = 15 \text{ mA}$	- $V_{CEsat}$	–	–	400 mV
$- I_C = 500 \text{ mA}, - I_B = 50 \text{ mA}$	- $V_{CEsat}$	–	–	1.6 V
Base saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung <sup>1)</sup>				
$- I_C = 150 \text{ mA}, - I_B = 15 \text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	–	1.3 V
$- I_C = 500 \text{ mA}, - I_B = 50 \text{ mA}$	- $V_{BEsat}$	–	–	2.6 V

<sup>1)</sup> Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
 Montage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß

Characteristics ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )Kennwerte ( $T_j = 25^\circ\text{C}$ )

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup>				
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 0.1 \text{ mA}$	MMBT2709 MMBT2709A	$h_{FE}$ $h_{FE}$	35 75	– –
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 1 \text{ mA}$	MMBT2709 MMBT2709A	$h_{FE}$ $h_{FE}$	50 100	– –
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 10 \text{ mA}$	MMBT2709 MMBT2709A	$h_{FE}$ $h_{FE}$	75 100	– –
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 500 \text{ mA}$	MMBT2709 MMBT2709A	$h_{FE}$ $h_{FE}$	30 50	– –
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 150 \text{ mA}$		$h_{FE}$	100	– 300
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz				
- $V_{CE} = 20 \text{ V}$ , - $I_C = 50 \text{ mA}$ , $f = 100 \text{ MHz}$		$f_T$	200 MHz	– –
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität				
- $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$		$C_{CBO}$	–	– 8 pF
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität				
- $V_{EB} = 2 \text{ V}$ , $I_C = i_c = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$		$C_{EBO}$	–	– 30 pF
Noise figure – Rauschzahl				
- $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , - $I_C = 100 \mu\text{A}$ , $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ , $f = 10 \text{ Hz...}15.7 \text{ kHz}$		F	–	4 dB –
Switching times – Schaltzeiten				
turn-on time	- $V_{CC} = 30 \text{ V}$ , - $V_{BE} = 1.5 \text{ V}$	$t_{on}$	–	– 45 ns
delay time	- $I_C = 150 \text{ mA}$ , - $I_{B1} = 15 \text{ mA}$	$t_d$	–	– 10 ns
rise time		$t_r$	–	– 40 ns
turn-off time	- $V_{CC} = 30 \text{ V}$ , - $I_C = 150 \text{ mA}$	$t_{off}$	–	– 100 ns
storage time	- $I_{B1} = -I_{B2} = 15 \text{ mA}$	$t_s$	–	– 80 ns
fall time		$t_f$	–	– 30 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	420 K/W <sup>2)</sup>
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren				MMBT2222, MMBT2222A

Marking - Stempelung

MMBT2907A = 2F MMBT2907 = (M)2B

<sup>1)</sup> Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$ <sup>2)</sup> Mounted on P.C. board with  $3 \text{ mm}^2$  copper pad at each terminal  
Montage auf Leiterplatte mit  $3 \text{ mm}^2$  Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluß